

# 2SK530

## シリコンNチャンネルMOS形電界効果トランジスタ( $\pi$ -MOS)

- 高速高電圧スイッチング用
- スwitchングレギュレータ, DC-DC コンバータ用
- モータドライブ用

通 信 工 業 用

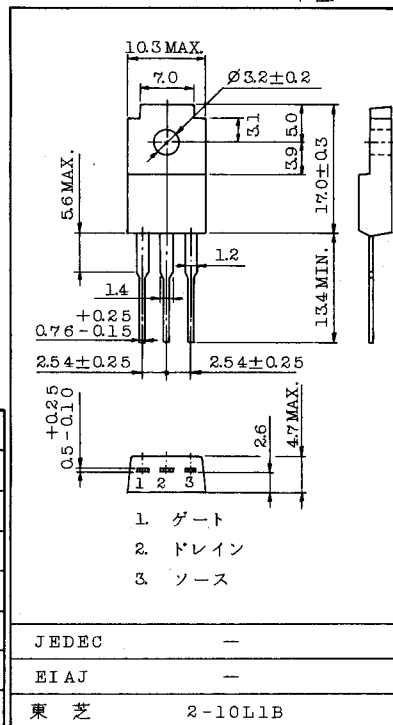
単位: mm

### 特 長

- ・ 高耐圧です。 :  $V_{(BR)DSS}=400V$
- ・ 順方向伝達アドミタンスが高い。 :  $|Y_{fs}|=2.5S$  (標準) ( $I_D=3A$ )
- ・ 漏れ電流が低い。 :  $I_{GSS}=\pm 100nA$  (最大) ( $V_{GS}=\pm 20V$ )  
 $I_{DSS}=1mA$  (最大) ( $V_{DS}=400V$ )
- ・ 取扱いが簡単な, エンハンスメントタイプです。
- ・ 絶縁ブッシング, マイカ等が不要な TO-220 相当のアイソレーションパッケージです。

最大定格 ( $T_a=25^\circ C$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSX}$	400	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSS}$	$\pm 20$	V
ドレイン電流	DC	$I_D$	5
	パルス	$I_{DP}$	8
許 容 損 失 ( $T_c=25^\circ C$ )	$P_D$	40	W
チャネル温度	$T_{ch}$	150	$^\circ C$
保 存 温 度	$T_{stg}$	$-55 \sim 150$	$^\circ C$



電気的特性 ( $T_a=25^\circ C$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	最 小	標 準	最 大	単 位
ゲート漏れ電流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 20V, V_{DS}=0$	—	—	$\pm 100$	nA
ドレインシャ断電流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=400V, V_{GS}=0$	—	—	10	mA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=10mA, V_{GS}=0$	400	—	—	V
ゲートしきい値電圧	$V_{th}$	$V_{DS}=10V, I_D=1mA$	1.5	—	3.5	V
順方向伝達アドミタンス	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10V, I_D=3A$	1.0	2.5	—	S
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(ON)}$	$I_D=3A, V_{GS}=10V$	—	10	14	$\Omega$
ドレイン・ソース間オン電圧	$V_{DS(ON)}$	$I_D=8A, V_{GS}=10V$	—	10	18	V
入 力 容 量	$C_{iss}$	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	670	900	pF
帰 還 容 量	$C_{rss}$	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	50	90	pF
出 力 容 量	$C_{oss}$	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$	—	180	250	pF
スイッチング時間	上 昇 時 間		—	25	50	ns
	ターンオン時間		—	40	80	ns
	下 降 時 間		—	35	70	ns
	ターンオフ時間		—	140	280	ns

この製品は MOS 構造ですので取扱いの際には静電気にご注意ください。